

N-Channel FET

TIS14

30V / 10mA / 300mW

DATASHEET

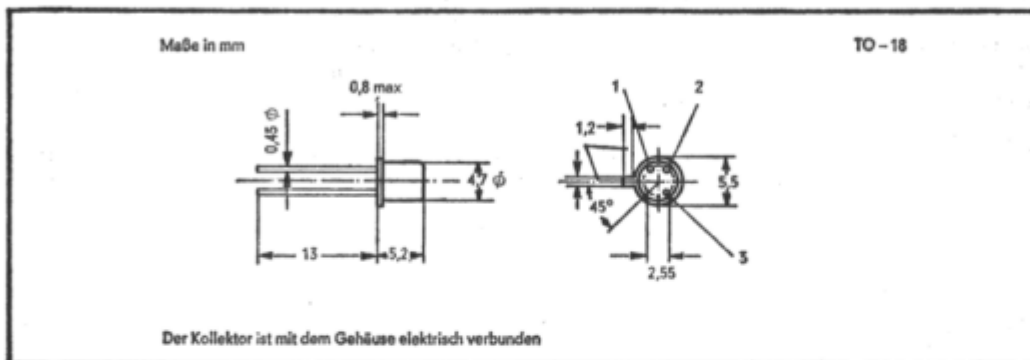
OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

TIS14

N-Kanal-Epitaxial-Planar-Silizium-Feldeffekt-Transistor

Feldeffekt-Transistor mit symmetrischem N-Kanal
für allgemeine Anwendungen

Mechanische Daten**Absolute Grenzwerte**

| | |
|---|--------------------|
| Drain-Source-Spannung | ± 30 V |
| Drain-Gate-Spannung | 30 V |
| Gate-Source-Sperrspannung | -30 V |
| Gate-Strom | 10 mA |
| Dauerverlustleistung bei (oder darunter) $T_U = 25$ °C (Bem. 1) | 300 mW |
| Lagerungs-Temperaturbereich | -65 °C bis +200 °C |
| Temperatur der Anschlüsse 1,6 mm vom Gehäuse (10 s) | 300 °C |

Bemerkung:

1. Lineare Abnahme bis $T_U = 175$ °C mit 2 mW/°C.

* JEDEC registriert.

Elektrische Kennwerte* bei $T_U = 25\text{ °C}$ (wenn nicht anders angegeben)

| Parameter | Prüfbedingungen** | min | max | Einh. |
|---------------|--------------------------------|-----|-----|---------------|
| $U_{(BR)GSS}$ | Gate-Source-Durchbruchspannung | | | V |
| I_{GSS} | Gate-Sperrstrom | | | nA |
| I_{DSS} | Drainstrom | | | μA |
| U_{GS} | Gate-Source-Spannung | | | V |
| U_{GS} | Pinch-off-Spannung | | | V |
| $ y_{21s} $ | Vorwärtssteilheit | | | μS |
| $ y_{22s} $ | Ausgangsleitwert | | | μS |
| C_{11s} | Eingangskapazität | | | pF |
| $-C_{12s}$ | Rückwirkungskapazität | | | pF |
| $ y_{21s} $ | Vorwärtssteilheit | | | μS |

Bemerkungen:

2. Impulsmäßig gemessen: Impulsbreite $\leq 100\ \mu\text{s}$
Tastverhältnis $\leq 10\%$

** Der vierte Anschluß (Gehäuse) muß bei allen Messungen mit Source verbunden sein.

* JEDEC registriert.